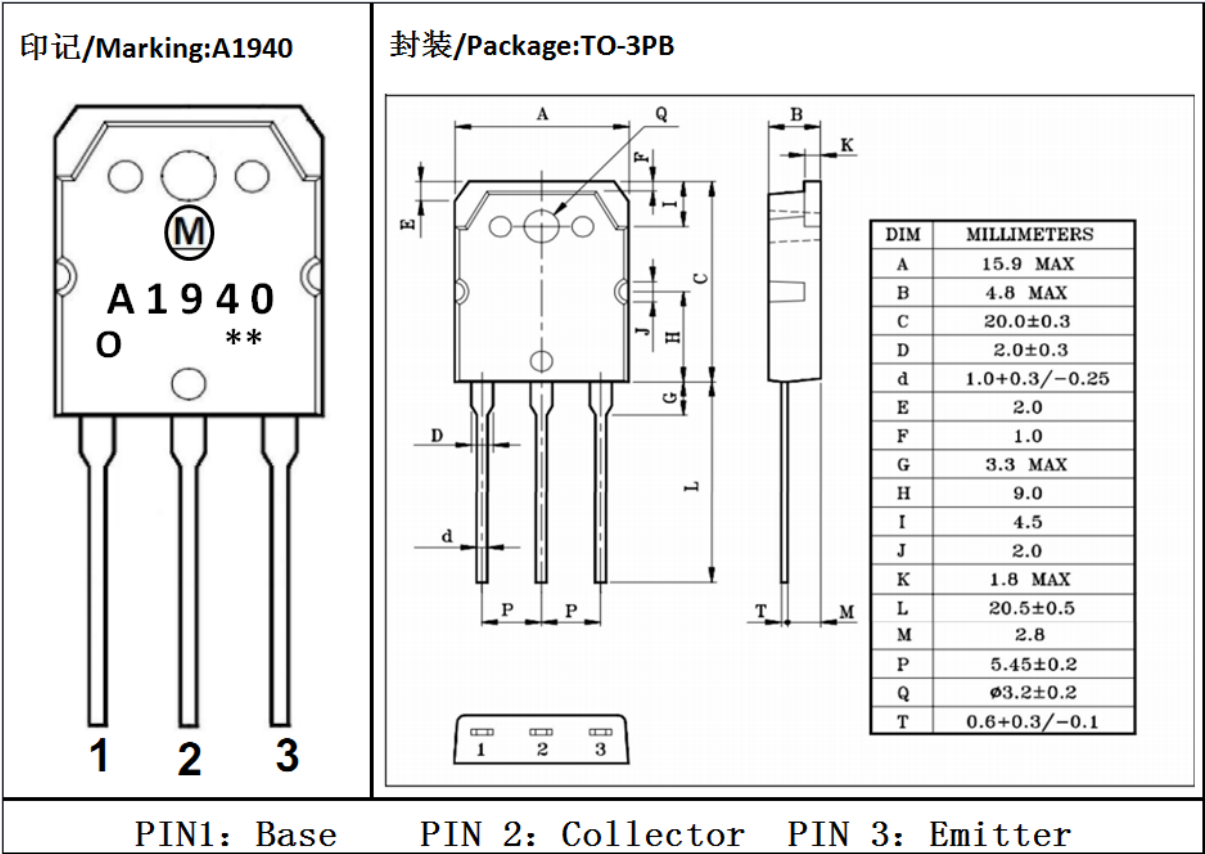


描述: <ul style="list-style-type: none"> ● T0-3PB 塑封封装 PNP 半导体三极管 	DESCRIPTIONS: <ul style="list-style-type: none"> ● Silicon PNP transistor in a T0-3PB Plastic Package
用途: <ul style="list-style-type: none"> ● 通用 ● 应用 55W 音频功率输出 	APPLICATIONS: <ul style="list-style-type: none"> ● General purpose ● For 55W audio frequency amplifier output stage
特性: <ul style="list-style-type: none"> ● 与 2SC5197 互补 ● 环保 (ROHS) 产品 	FEATURES: <ul style="list-style-type: none"> ● Complementary to 2SC5197 ● ROHS Product
外观 / Package: <ul style="list-style-type: none"> ● 封装/Package:T0-3PB ● 印记/Marking:A1940 	



热特性 / THERMAL CHARACTERISTIC:

项 目 Parameter	符号 Symbo	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit
节到管壳的热阻 Thermal Resistance Junction Case T0-3PB	$R_{th(j-c)}$	—	1.65	℃/W

最大额定参数 / Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
集电极—基极直流电压 Collector — Base Voltage	V_{CBO}	-120	V
集电极—发射极直流电压 Collector — Emitter Voltage	V_{CEO}	-120	V
发射极—基极直流电压 Emitter — Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
集电极电流 Collector Current	I_C	-8	A
基极电流 Base Current	I_B	-0.8	A
集电极耗散功率 Collector Dissipation (Tc=25°C)	P_C	60	W
结温 Junction Temperature	T_j	150	°C
贮存温度范围 Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
VCBO	IC=-1.0mA IE=0	-120			V
VCEO	IC=-50.0mA IB=0	-120			V
VEBO	IE=-1.0mA IC=0	-5.0			V
ICBO	VCB=-120V IE=0			-5.0	μ A
IEBO	VEB=-5.0V IE=0			-5.0	μ A
hFE(1)	VCE=-5.0V IC=-1.0A	55		160	
hFE(2)	VCE=-5.0V IC=-4.0A	35	75		
VCE(sat)	IC=-6A IB=-0.6A			-2.0	V
VBE	VCE=-5.0V IC=-4.0A		-0.92	-1.5	V
fT	IC=-1.0A VCE=-5.0V f=100MHz		30		MHz
Cob	VCB=-10V IE=0 f=1.0MHz		260		pF

放大及印章代码 / hFE Classifications & Marking

印章代码/ Classifications & Marking	R	O
放大/hFE Range	55~110	80~160

特征曲线 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

